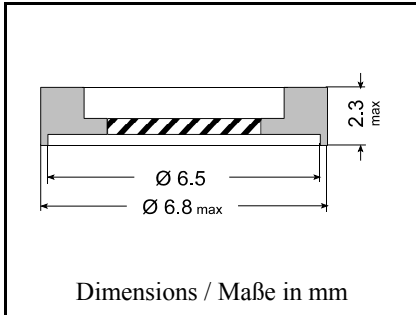


**Silicon Rectifier Cells  
with polysiloxan passivation**

**Silizium-Gleichrichterzellen  
mit Polysiloxan-Passivierung**



Nominal current – Nennstrom 12 A  
 Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V  
 Periodische Spitzensperrspannung  
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.3 g  
 Standard packaging bulk  
 Standard Lieferform lose

**Maximum ratings and Characteristics**

**Kenn- und Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
AG 12A	50	80
AG 12B	100	130
AG 12D	200	250
AG 12G	400	450
AG 12J	600	700
AG 12K	800	1000
AG 12M	1000	1300

Max. forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	12 A <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	$I_{FRM}$	60 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	500 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	1250 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	- 50...+150°C - 50...+150°C
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 12\text{ A}$	$V_F$ < 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$ < 10 µA

<sup>1)</sup> Max. temperature of the terminals  $T_T = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Kontaktflächen  $T_T = 100^\circ\text{C}$